



内置高精度振荡、LCD 驱动、12 位 ADC、3 个定时器、1 路 UART、1 路 SPI、

16K Flash 存储器和 256B 可编程 E2PROM 的 8 位 MCU

## 主要特点

### ● 8 位 LC51 CPU

- 兼容 MCS51 指令集；双 DPTR；增加软件陷阱指令。
- 改进的指令架构，90%的指令执行时间为两至四个系统时钟周期。

### ● 片上存储器

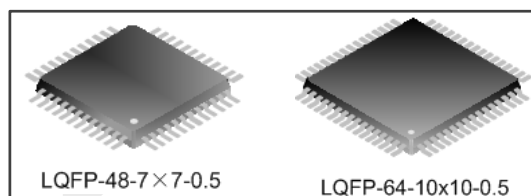
- 16K+64 字节 FLASH，数据保持时间大于 10 年，写周期>1000 次。
- 256 字节 EEPROM，数据保持时间大于 10 年，写周期>10000 次；
- 512 字节 RAM。
- 支持在系统编程（ISP），仅需 5 个管脚（包括 VDD 和 VSS 在内）。
- 支持 FLASH 分页加密，每 512 字节单独读写可控。

### ● 电源和复位

- 工作电压：VDD=2.0V~5.5V。
- 内置上电复位电路（POR）。
- 内置低压复位电路（LVR），8 个复位点可选：1.8V,2.0V, 2.5V, 2.6V, 2.8V, 3.0V, 3.5V, 4.0V。
- 内置低压检测电路（LVD），8 个检测点可选：2.2V, 2.4V, 2.5V, 2.7V, 2.9V, 3.1V, 3.65V,4.5V。
- 内置看门狗定时器（WDT）。

### ● 时钟系统

- 内置 32KHz 低频 RCL。
- 内置 8MHz 高精度 RCH，精度  $\pm 1.5\%$  @VDD=2.0~5.5V, TA=-40°C~+105°C。



- 外部高频振荡 1~8MHz，或者外部低频振荡 32.768KHz，两者复用同一组管脚，由信息区配置。
- 系统时钟预分频系数：8/4/2/1。
- CPU 最高主频 8MHz @VDD=2.5V~5V。4MHz@VDD=2.0~2.5V；

### ● 输入/输出

- 最大支持 50 个 I/O 端口。
- 每个 IO 都可设置成 4 种模式：悬空输入/上拉输入/推挽输出/开漏输出。
- I/O 驱动能力和斜率可调节；
- P0/P1/P2/P4 口具有键盘中断唤醒功能；中断极性可设。
- 4 路外部中断输入；中断极性可设。

### ● 定时器

- 2 个 16 位定时器（T0、T1），兼容传统 MCS51 功能。且 T0 支持方波输出，T1 支持 PWM 输出。
- 1 个带捕获功能的 16 位定时器 T2，支持两路 PWM 波输出，占空比可以任意配置。
- 1 个 8 位 WT 定时器，可产生四种频率蜂鸣信号：8K/4K/2K/1KHz。

### ● 串行通信口

- 1 路 UART 通讯口，可配置高精度波特率。
- 1 路 SPI 通讯口，最高支持 4M 数据传输速率 @MCLK=8MHz。

- 模拟

- 1 路轨到轨的模拟比较器 (ACMP)，内置 16 级电阻分压参考电平，内置基准电压可被选为电阻分压源。
- 内置电阻型 LCD 驱动器，电阻型 LCD 对比度 8 级可调，3 种驱动能力可选，具有快速充电模式；最大支持 4X35 段，5X34 段，6X33 段；1/2、1/3 偏置可选。

表 1 产品信息

产品名称	封装形式
LCM08F16L48F	LQFP48L-0707x1.4
LCM08F16L64F	LQFP64-1010x1.4

- 工作模式

- 正常工作模式。
- 休眠 (Sleep) 模式。
- 停机 (STOP) 模式。

- 工作温度

- 环境温度：-40°C~+105°C。



## 目录

1. 产品描述 .....	4
2. 资源对照表 .....	4
3. 引脚描述 .....	5
3.1 引脚封装 .....	5
3.2 引脚复用 .....	7
3.3 引脚描述 .....	9
4. 电气特性 .....	12
4.1 绝对最大值 .....	12
4.2 推荐工作条件 .....	13
4.3 直流电气特性 .....	14
5. 历史版本 .....	18

## 图

图 1 LCM08F16xx 内部框图 .....	4
图 2 LQFP48 封装 .....	5
图 3 LQFP64 封装图 .....	6

## 表

表 1 产品信息 .....	2
表 2 引脚复用 .....	7
表 3 引脚功能描述 .....	9
表 4 电压特性 .....	12
表 5 电流特性 .....	12
表 6 热特性 .....	12
表 7 ESD 保护和 Latch-up 免疫特性 .....	12
表 8 工作条件 .....	13
表 9 电流特性 .....	14
表 10 I/O 特性 .....	14
表 11 系统监控与复位特性 .....	16
表 12 模拟比较起特性 .....	17
表 13 振荡与时钟特性 .....	17
表 14 LCD 驱动特性 .....	17

## 1. 产品描述

LCM08F16XX 是一款集成 LCD 驱动 8 位 MCU，整体架构如图 1 所示。它采用 LC51 核，内置 16K 字节 Flash 、512 字节 RAM 及 256 字节 E2PROM，内置 8MHz 高精度 RC 振荡、轨到轨的模拟比较器、12 位高精度 ADC，具有灵活的时钟系统、丰富的定时器资源和通讯接口，使其适合多种控制应用。2.0V~5.5V 的工作电压范围、极低待机显示电流、超低停机电流，使其特别适合电池供电应用和带面板显示的系统，如：对讲机、医疗保健设备、面板显示、智能仪表等。

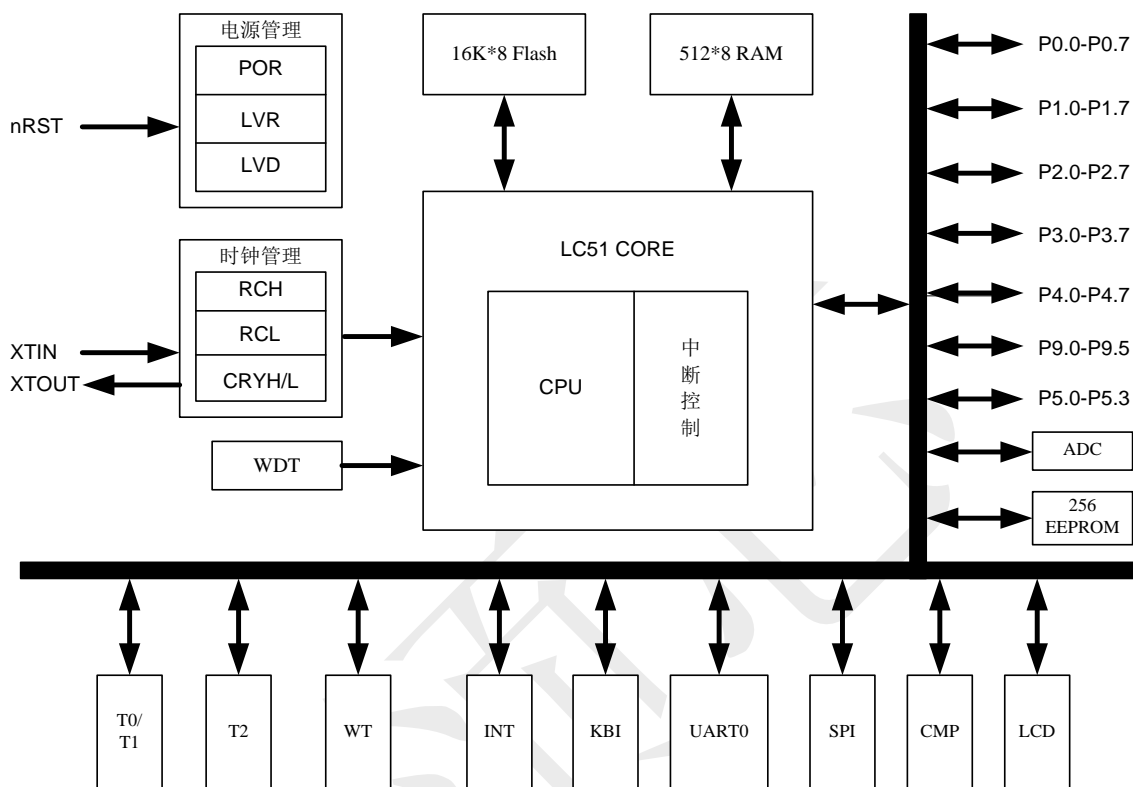


图 1 LCM08F16xx 内部框图

## 2. 资源对照表

特征	LCM08F16	
	LQFP-48	LQFP-64
封装	LQFP-48	LQFP-64
FLASH	16K*8	
RAM	512*8	
I/O	45	50
外部中断	4	4
T0	有	有
T1	有	有
T2	有	有
PWM	有	有
WT	有	有
KBI	32	32
CMP	有	有

UART	有	有
SPI	有	有
LCD	4*32/5*31/6*30	4*35/5*34/6*33

### 3.引脚描述

#### 3.1 引脚封装

LQFP48 封装

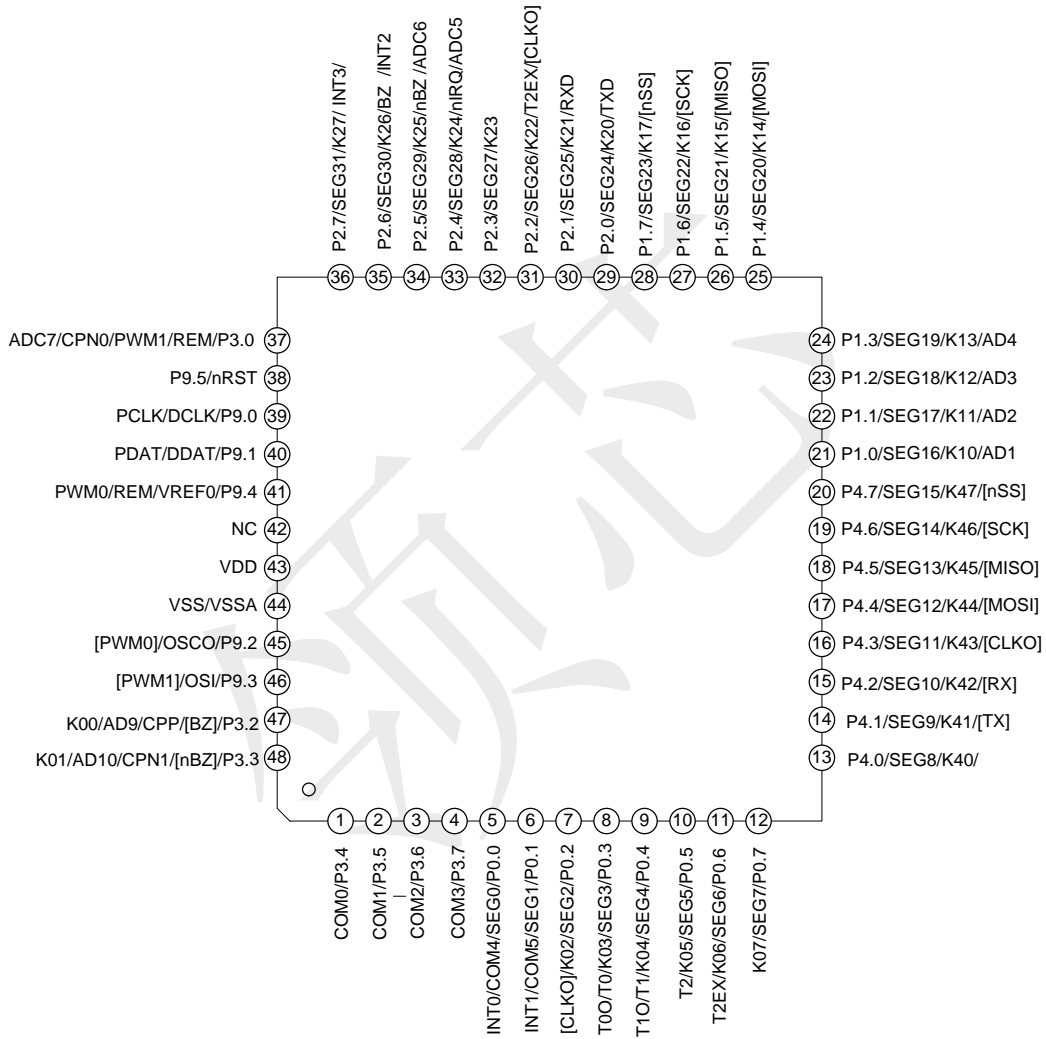


图 2 LQFP48 封装

## LQFP64 封装

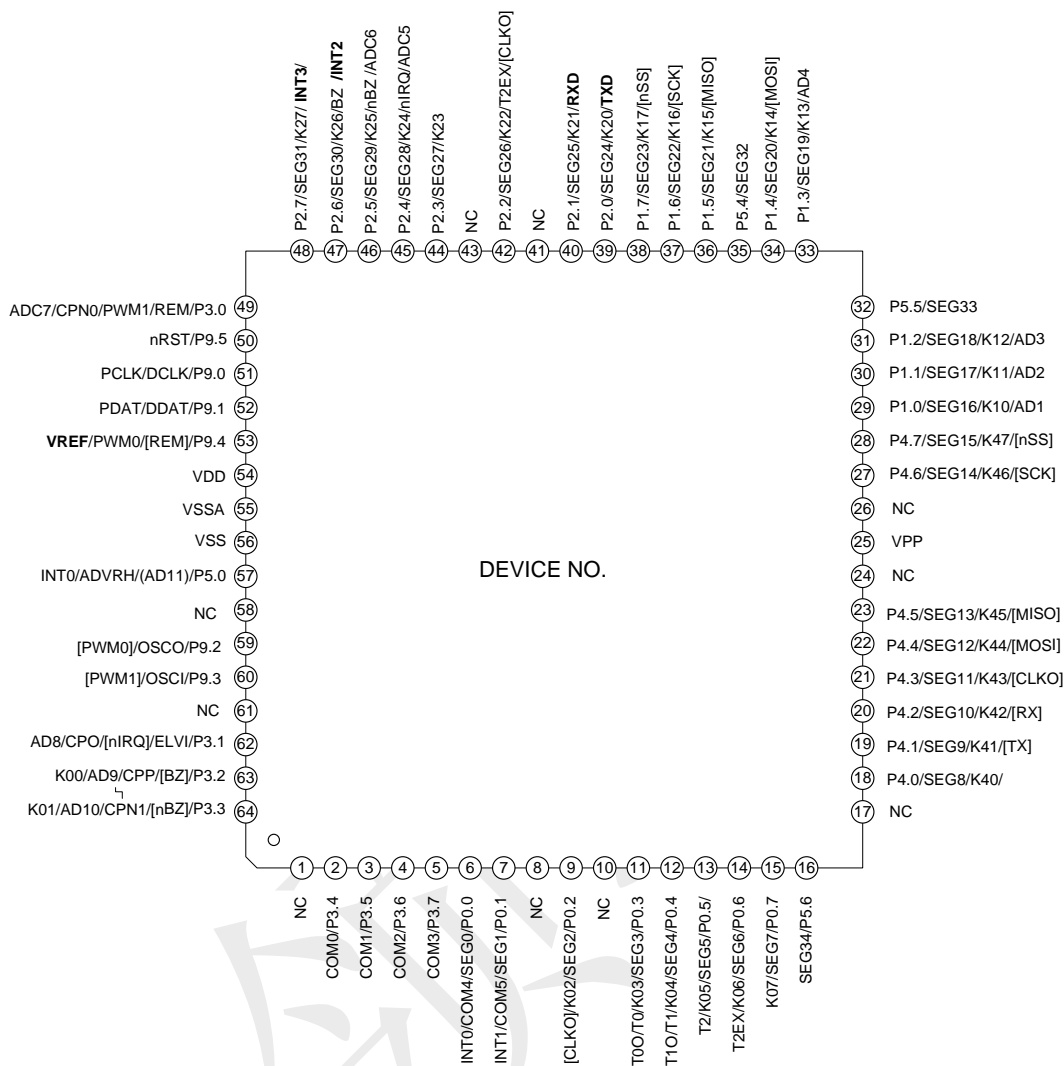


图 3 LQFP64 封装图

### 3.2 引脚复用

表 2 引脚复用

I/O	管脚结构	管脚号		驱动能力 <sup>注1</sup> (3.3V)		系统	定时器	键盘中断	通信接口	比较器	LCD 驱动	ADC
		48	64	DS=0	DS=1							
P0.0	T1	5	6	2mA	20mA	INT0	--		--	--	SEG0/ COM4	--
P0.1	T1	6	7	2mA	20mA	INT1	--		--	--	SEG1/ COM5	--
P0.2	T2	7	9	2mA	8mA	[CLKO]	--	KI02	--	--	SEG2	--
P0.3	T2	8	11	2mA	8mA	--	T0/T0O	KI03	--	--	SEG3	--
P0.4	T2	9	12	2mA	8mA	--	T1/T1O	KI04	--	--	SEG4	--
P0.5	T2	10	13	2mA	8mA	--	T2	KI05	--	--	SEG5	--
P0.6	T2	11	14	2mA	8mA	--	T2EX	KI06	--	--	SEG6	--
P0.7	T2	12	15	2mA	8mA	--	--	KI07	--	--	SEG7	--
P1.0	T6	21	29	2mA	8mA	--	--	KI10	--	--	SEG16	AD1
P1.1	T6	22	30	2mA	8mA	--	--	KI11	--	--	SEG17	AD2
P1.2	T6	23	31	2mA	8mA	--	--	KI12	--	--	SEG18	AD3
P1.3	T6	24	33	2mA	8mA	--	--	KI13	--	--	SEG19	AD4
P1.4	T2	25	34	2mA	8mA	--	--	KI14	MOSI	--	SEG20	--
P1.5	T2	26	35	2mA	8mA	--	--	KI15	MISO	--	SEG21	--
P1.6	T2	27	37	2mA	8mA	--	--	KI16	SCK	--	SEG22	--
P1.7	T2	28	38	2mA	8mA	--	--	KI17	NSS	--	SEG23	--
P2.0	T2	29	39	2mA	8mA	--	--	KI20	TXD0	--	SEG24	--
P2.1	T2	30	40	2mA	8mA	--	--	KI21	RXD0	--	SEG25	--
P2.2	T2	31	42	2mA	8mA	[CLKO]	T2EX	KI22	--	--	SEG26	--
P2.3	T2	32	44	2mA	8mA	--	--	KI23	--	--	SEG27	--
P2.4	T6	33	45	2mA	8mA	--	nIRQ	KI24	--	--	SEG28	AD5
P2.5	T6	34	46	2mA	8mA	--	nBUZ	KI25	--	--	SEG29	AD6
P2.6	T2	35	47	2mA	8mA	INT2	BUZ	KI26	--	--	SEG30/VL1	--
P2.7	T2	36	48	2mA	8mA	INT3	--	KI27	--	--	SEG31/VL2	--
P3.0	T5	37	49	2mA	16mA	--	REM/ PWM1	--	--	CPN0	--	AD7
P3.1	T4	-	62	2mA	8mA	ELVI	nIRQ	--	--	CPO	--	AD8
P3.2	T4	47	63	2mA	8mA	--	BUZ	KI00	--	CPP	--	AD9
P3.3	T4	48	64	2mA	8mA	--	nBUZ	KI01	--	CPN1	--	AD10
P3.4	T3	1	2	2mA	20mA	--	--	--	--	--	COM0	--
P3.5	T3	2	3	2mA	20mA	--	--	--	--	--	COM1	--
P3.6	T3	3	4	2mA	20mA	--	--	--	--	--	COM2	--
P3.7	T3	4	5	2mA	20mA	--	--	--	--	--	COM3	--
P4.0	T2	13	18	2mA	8mA	--	--	KI40	--	--	SEG8	--
P4.1	T2	14	19	2mA	8mA	--	--	KI41	TXD0	--	SEG9	--

## 杭州领芯微电子有限公司

P4.2	T2	15	20	2mA	8mA	--	--	KI42	RXD0	--	SEG10	--
P4.3	T2	16	21	2mA	8mA	[CLKO]	--	KI43	--	--	SEG11	--
P4.4	T2	17	22	2mA	8mA	--	--	KI44	MOSI	--	SEG12	--
P4.5	T2	18	23	2mA	8mA	--	--	KI45	MISO	--	SEG13	--
P4.6	T2	19	27	2mA	8mA	--	--	KI46	SCK	--	SEG14	--
P4.7	T2	20	28	2mA	8mA	--	--	KI47	nSS	--	SEG15	--
P5.0	T7	-		2mA	8mA	INT0	--	--	--	--	--	AD11/ ADV RH
P5.4	T2	-	35	2mA	8mA	--	--	--	--	--	SEG32	--
P5.5	T2	-	32	2mA	8mA	--	--	--	--	--	SEG33	--
P5.6	T2	-	16	2mA	8mA	--	--	--	--	--	SEG34	--
P9.0	T5	39	51	2mA	16mA	PCLK	--	--	--	--	--	--
P9.1	T4	40	52	2mA	8mA	PDAT	--	--	--	--	--	--
P9.2	T4	45	59	2mA	8mA	XTOUT	PWM0	--	--	--	--	--
P9.3	T4	46	60	2mA	8mA	XTIN	PWM1	--	--	--	--	--
P9.4	T4	41	53	2mA	8mA	VREF/ [SE]	PWM0/ REM	--	--	--	--	--
P9.5	T5	38	50	2mA	16mA	nRST	--	--	--	--	--	--
VDD	/	43	54			--	--	--	--	--	--	--
VSS	/	44	56			--	--	--	--	--	--	--
AVSS	/	44	55			--	--	--	--	--	--	--

注：1. 该驱动能力以 3.3V 标准设计，5V 电压下可以达到更高的驱动能力；

2. 所有 I/O 的驱动能力都可以调节，请参考<LCM0016 用户手册>中寄存器 GPIODS0~GPIODS5 / GPIODS9 的描述。

3. 所有 I/O 的跳转 Rate 均可以按组设置，当使能 SlowRate 以后，可以减少 PAD 干扰，请参见<LCM0016 用户手册>GPIOISR 寄存器描述；



### 3.3 引脚功能

表 3 引脚功能描述

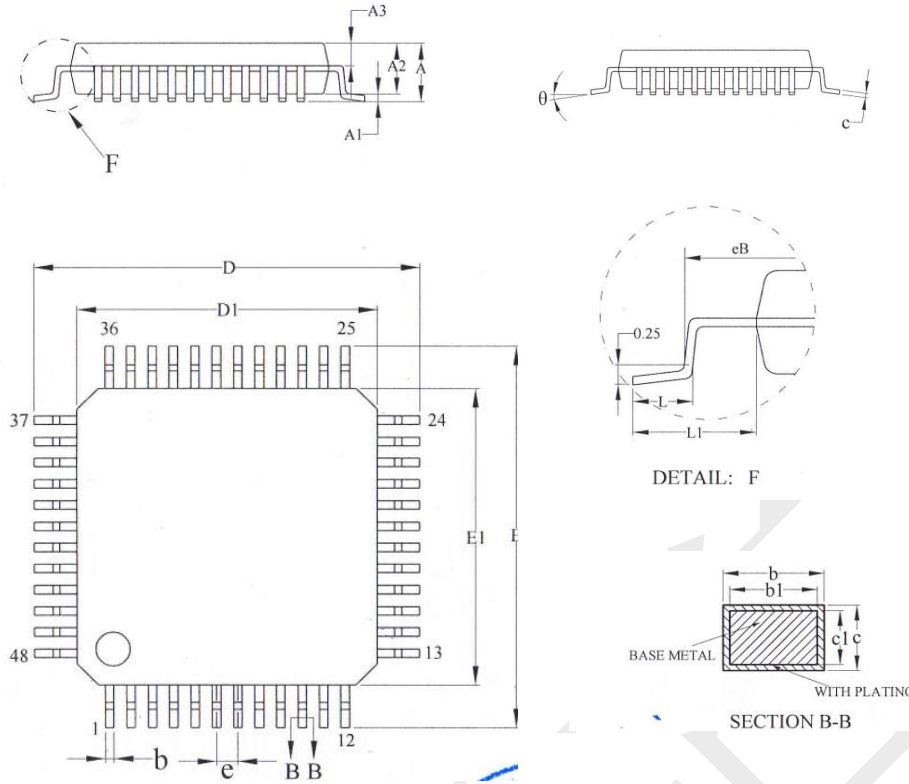
I/O	管脚属性	管脚描述
<b>端口</b>		
P0.0-P0.7	I/O	8 位双向 I/O 口, 可位操作
P1.0-P1.7	I/O	8 位双向 I/O 口, 可位操作
P2.0-P2.7	I/O	8 位双向 I/O 口, 可位操作
P3.0-P3.7	I/O	8 位双向 I/O 口, 可位操作
P4.0-P4.7	I/O	8 位双向 I/O 口, 可位操作
P5.0/5.4/5.5/5.6	I/O	4 位双向 I/O 口, 可位操作
P9.0-P9.5	I/O	6 位双向 I/O 口, 可位操作
<b>烧录</b>		
[VPP]	P	高压烧录脚 (电压 9.0V~10V, 使用内部 ChargePump 烧录时候, 悬空即可)
[PCLK]	I	编程时钟输入脚
[PDATA]	I/O	编程数据输入输出脚
<b>系统</b>		
nRST	P	外部复位脚, 低电平有效
CLKO	O	时钟输出
INT0~INT3	I/O	外部中断 0~3
ELVI	I	低压检测外部输入电压
VREF	O	基准电压
<b>定时器</b>		
T0	I	T0 外部计数输入
T1	I	T1 外部计数输入
T0O	O	T0 方波输出
T1O	O	T1 PWM 输出
T2EX	I	T2 捕获输入
PWM0/1	O	T2 PWM 输出
nIRQ	O	WT IRQ 输出
BUZ	O	蜂鸣器正相输出
nBUZ	O	蜂鸣器反相输出
<b>KBI</b>		
KI02~KI07	I	P0 口 6 位键盘中断
KI10~KI17	I	P1 口 8 位键盘中断
KI20~KI27	I	P2 口 8 位键盘中断
KI32、KI33	I	P3 口 2 位键盘中断
KI40~KI47	I	P4 口 8 位键盘中断
<b>通信接口</b>		
NSS	I/O	SPI 使能脚
MISO	I/O	SPI 主入从出脚
MOSI	I/O	SPI 主出从入脚

# 杭州领芯微电子有限公司

I/O	管脚属性	管脚描述
SCK	I/O	SPI 时钟脚
TXD0	O	UART0 数据输出脚
RXD0	I	UART0 数据输入脚
<b>模拟比较器</b>		
CPP	I	比较器正端输入脚
CPN0	I	比较器负端输入脚 0
CPN1	I	比较器负端输入脚 1
CPO	O	比较器输出
<b>LCD 驱动</b>		
SEG0~SEG34	O	LCD Segment 输出
COM0~COM5	O	LCD Com 输出
<b>ADC</b>		
AD1~AD10	I	AD 电压采通道
ADVRH	I/O	AD 正参考电压外接管脚功能或者 ADC 正电压输出管脚，受 ADPREF 寄存器控制
<b>Power supply</b>		
VDD	P	电源电压
VSS	P	地
AVSS	P	地

注：管脚属性这一列中，P 表示 电源管脚，I/O 表示通用输入/输出脚，I 表示输入脚，O 表示输出脚。

## 4. 封装外形图



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.60
A1	0.05	—	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.18	—	0.26
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	—	0.17
c1	0.12	0.13	0.14
D	8.80	9.00	9.20
D1	6.90	7.00	7.10
E	8.80	9.00	9.20
E1	6.90	7.00	7.10
eB	8.10	—	8.25
e	0.50BSC		
L	0.40	—	0.65
L1	1.00REF		
θ	0	—	7°

## 5 电气特性

### 5.1 绝对最大值

如果器件工作条件超过“绝对最大值”，就可能会对器件造成永久性损坏。这些值仅为运行条件极大值，我们建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大值条件下，其可靠性会受到影响。

表 4 电压特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	$V_{DD}$	-	-0.3	-	5.5V	V
输入电压	$V_{IN}$	-	-0.3	-	$V_{DD}+0.3$	

注：所有电压都以  $V_{SS}$  为参考。

表 5 电流特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
流入 $V_{DD}$ 的总电流	$I_{VDD}$	-	-	-	80	mA
流出 $V_{SS}$ 的总电流	$I_{VSS}$	-	-	-	80	
管脚注入电流	$I_{INJ}$	$V_{IN} > V_{DD}$ 或 $V_{IN} < V_{SS}$	-4	-	4	
		$V_O > V_{DD}$ 或 $V_O < V_{SS}$	-4	-	4	
总注入电流	$\Sigma I_{INJ}$	-	-20	-	20	

表 6 热特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
环境温度	$T_A$	-	-40	-	85	°C
存储温度	$T_{STG}$	-	-55	-	125	
结温	$T_J$	-	-	-	150	
热阻	$\theta_{JA}$	LQFP-48	-	78	-	°C/W
		LQFP-64	-	76	-	
总功耗	$P_D$	-	-	-	500	mW

表 7 ESD 保护和 Latch-up 免疫特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
HBM	$V_{HBM}$	MIL-STD-883H	$\pm 4000$	-	-	V
MM	$V_{MM}$	JESD22-A115	$\pm 200$	-	-	
CDM	$V_{CDM}$	JESD22-C101E	$\pm 1000$	-	-	
Latch-up 触发电流	$I_{LAT}$	JEDEC standard NO.78D 2011.11	$\pm 100$	-	-	mA
$V_{DD}$ 过压	$V_{LAT}$		TBD	-	-	V

## 5.2 推荐工作条件

表 8 工作条件

参 数	符号	测 试 条 件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	$V_{DD}$	-	1.8	-	5.5	V
CPU 时钟频率	$F_{CPU}$	$V_{DD} > 1.8V$	0	-	4	MHz
		$V_{DD} > 2.5V$	-	-	8	
上电复位释放电压	$V_{POR}$	-	-	1.8	-	V
上电复位延迟时间	$t_{PWRT}$	-	1	20	-	ms
VDD 上升速率	$S_{VDD}$	确保能够产生内部上电复位信号	0.1	-	-	V/ms
RAM 保持电压	$V_{DR}$	$T_A = -40 \sim 85^\circ C$	1.8	-	-	V

### 5.3 直流电气特性

本芯片典型工作电压 3.3V / 5.0V, 除非特别指明, 否则典型值是在 VDD=3.0V 注 1、TA=25° C 条件的测试结果。直流电气特性还在不断完善中, TBD 部分将会逐步更新。

表 9 电流特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电流	I <sub>RUN</sub>	MCLK=1MHz, RCH/8	-	1.3	-	mA
		MCLK=2MHz, RCH/4	-	2	-	
		MCLK=4MHz, RCH/2	-	2.2	-	
		MCLK=8MHz, RCH/1	-	3.1	-	
		MCLK=1MHz, CRY8M/8, 最大增益	-	TBD	-	
		MCLK=2MHz, CRY8M/4, 最大增益	-	TBD	-	
		MCLK=4MHz, CRY8M/2, 最大增益	-	TBD	-	
		MCLK=8MHz, CRY8M/1, 最大增益	-	TBD	-	
		MCLK=1MHz, CRY4M/4, 最大增益	-	TBD	-	
		MCLK=4MHz, CRY4M/1, 最大增益	-	TBD	-	
		MCLK=32KHz, CRY32K/1, 大增益	-	TBD	-	uA
待机电流	I <sub>SLEEP</sub>	MCLK=1MHz, RCH/8	-	0.25	-	mA
		MCLK=2MHz, RCH/4	-	0.33	-	
		MCLK=4MHz, RCH/2	-	0.43	-	
		MCLK=8MHz, RCH/1	-	0.5	-	
		MCLK=8MHz, CRY8M/1, 最大增益	-	TBD	-	
		MCLK=4MHz, CRY4M/1, 最大增益	-	TBD	-	
		MCLK=32KHz, CRY32K/1, 大增益	-	TBD	-	uA
停机电流	I <sub>stop</sub>	所有模块关闭	-	1	-	uA

注: 测量电流特性时遵循下列条件:

- \* 所有 IO 都设置成输出低电平, 无负载。
- \* 除非特别指明, 所有外设都关闭。

表 10 I/O 特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位		
高电平输入电压	V <sub>IH</sub>	所有 IO	0.7*V <sub>DD</sub>	-	V <sub>DD</sub>	V		
低电平输入电压	V <sub>IL</sub>	所有 IO			0.3 V <sub>DD</sub>			
输入迟滞	V <sub>HYS</sub>	所有 IO		TBD		mv		
输出管脚拉电流	I <sub>OH</sub>	V <sub>DD</sub> =3V, V <sub>OH</sub> =0.7*V <sub>DD</sub>	弱驱动 (DS=0)	T0 类型	-	3	-	mA
				T1 类型	-	3	-	mA
				T2 类型	-	3	-	mA
				T3 类型	-	3	-	mA
				T4 类型	-	3	-	mA
				T5 类型	-	3	-	mA
				T6 类型	-	3	-	mA

# 杭州领芯微电子有限公司

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位				
			强驱动 (DS=1)	T7 类型	-	3	-	mA		
				T0 类型	-	10	-	mA		
				T1 类型	-	20	-	mA		
				T2 类型	-	11	-	mA		
				T3 类型	-	20	-	mA		
				T4 类型	-	12	-	mA		
				T5 类型	-	16	-	mA		
				T6 类型	-	10	-	mA		
				T7 类型	-	10	-	mA		
				弱驱动 (DS=0)	T0 类型	-	6.5	-	mA	
					T1 类型	-	6.5	-	mA	
					T2 类型	-	6.5	-	mA	
					T3 类型	-	6.5	-	mA	
					T4 类型	-	6.5	-	mA	
		T5 类型	-		6.5	-	mA			
		T6 类型	-		6.5	-	mA			
		强驱动 (DS=1)	T0 类型	-	25	-	mA			
			T1 类型	-	40	-	mA			
			T2 类型	-	25	-	mA			
			T3 类型	-	40	-	mA			
			T4 类型	-	25	-	mA			
			T5 类型	-	34	-	mA			
			T6 类型	-	20	-	mA			
		T7 类型	-	25	-	mA				
		输出管脚灌电流	I <sub>OL</sub>	V <sub>DD</sub> =3V, V <sub>OL</sub> =0.3*V <sub>DD</sub>	弱驱动 (DS=0)	T0 类型	-	3.5	-	mA
						T1 类型	-	5	-	mA
						T2 类型	-	3.5	-	mA
						T3 类型	-	5	-	mA
T4 类型	-					5	-	mA		
T5 类型	-					5	-	mA		
T6 类型	-					4.5	-	mA		
T7 类型	-					3.5	-	mA		
强驱动 (DS=1)	T0 类型					-	16	-	mA	
	T1 类型					-	35	-	mA	
	T2 类型					-	18	-	mA	
	T3 类型					-	35	-	mA	
	T4 类型					-	19	-	mA	
	T5 类型					-	23	-	mA	
T6 类型	-			16	-	mA				
T7 类型	-			15	-	mA				
V <sub>DD</sub> =5V,	弱驱动			T0 类型	-	9	-	mA		

# 杭州领芯微电子有限公司

参数	符号	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位	
		$V_{OL}=0.3*V_{DD}$	(DS=0)	T1 类型		9		mA
				T2 类型		9		mA
				T3 类型		9		mA
				T4 类型		9		mA
				T5 类型		9		mA
				T6 类型		9		mA
				T7 类型		9		mA
		强驱动 (DS=1)	T0 类型	-	20	-	mA	
			T1 类型	-	60	-	mA	
			T2 类型	-	34	-	mA	
			T3 类型	-	65	-	mA	
			T4 类型	-	25	-	mA	
			T5 类型	-	43	-	mA	
			T6 类型	-	23	-	mA	
T7 类型	-	20	-	mA				
总电流	$I_{total}$	-	所有端口	-	TBD	-	mA	
端口内置上拉电阻	$R_{pu}$	$V_{IN}=0V$		-	TBD	-	k $\Omega$	
端口输入漏泄电流 (高温)	$I_{IL}$	$V_{SS} < V_{PIN} < V_{DD}, T_A=85^{\circ}C$		-	$\pm 20$	$\pm 100$	nA	
滤波宽度	$T_{PW}(IO)$	外部复位脚		-	2	4	us	

表 11 系统监控与复位特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
带隙基准电压	$V_{BG}$	1.8~5.5V, -40~85 $^{\circ}C$	1.24	1.25	1.26	V
低压复位电压	$V_{LVR}$	LVRS=000	-	1.8	-	V
		LVRS=001	-	2.0	-	V
		LVRS=010	-	2.5	-	
		LVRS=011	-	2.6	-	
		LVRS=100	-	2.8	-	
		LVRS=101	-	3.0	-	
		LVRS=110	-	3.5	-	
		LVRS=111	-	4.0	-	
LVR 释放迟滞电压	$V_{HYS(LVR)}$	-	-	100	-	mV
LVR 模块工作电流	$I_{LVR}$	SLEEP 模式开启	-	20	-	uA
LVD 检测电压	$V_{LVD}$	LVLS= 000	-	2.1	-	V
		LVLS = 001	-	2.4	-	
		LVLS = 010	-	2.5	-	
		LVLS = 011	-	2.7	-	
		LVLS = 100	-	2.9	-	
		LVLS = 101	-	3.1	-	



# 杭州领芯微电子有限公司

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
		LVLS = 110	-	3.6	-	
		LVLS = 111	-	4.5	-	
LVD 释放迟滞电压	$V_{HYS(LVD)}$	-	100	-	200	mV
LVD 模块工作电流	$I_{LVD}$	SLEEP 模式开启	-	40	-	uA

表 12 模拟比较起特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
典型值工作条件为 $V_{DD}=3.0V$ , 温度=25°C, $V_{cm}=V_{DD}/2$ 。						
输入失调电压* (CPP 上升沿)	$V_{os}$	-	-10	0	10	mV
输入共模电压	$V_{cm}$	响应时间<160ns	0	-	$V_{DD}$	V
共模抑制比	CMRR	室温 25°C	-	1	-	mV/V
比较器迟滞电压	$V_{hyster}$		-	15	-	mV
启动延迟时间	$T_{str}$		-	0.5	1	us
响应时间	上升沿	VDD 做分压电阻基准	-	100	200	ns
	下降沿		-	100	200	ns
工作电流	$I_{cmp}$	-	-	25	35	uA
CVREF 稳定时间	$T_{scvr}$	-	-	1	-	us

表 13 振荡与时钟特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
经过校准的 RCH 频率	$F_{RCH}$	1.8~5.5V, -10~50°C	7.92	8.00	8.08	MHz
		1.8~5.5V, -40~105°C	7.84	8.00	8.16	
RCH 工作电流	$I_{RCH}$	5.0V, 25°C	-	100	-	uA
RCL 频率	$F_{RCL}$	1.8~5.5V, -40~85°C	6	32	50	KHz
RCL 工作电流	$I_{RCL}$	-	-	0.3	1.0	uA

表 14 LCD 驱动特性

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
典型值工作条件为 $V_{DD}=3.0V$ , 温度=25°C。						
LCD 驱动模块电流	$I_{lcd}$	电阻型	--	3	--	μA
LCD 基准固定输出电压	$V_{ivr}$	IVRCFG=0	--	1.018	--	V
LCD 择输基准选出电压	$V_{ivr}$	IVRCFG=1, VOUTSEL=000	--	0.7	--	
		IVRCFG=1, VOUTSEL=001	--	0.8	--	
		IVRCFG=1, VOUTSEL=010	--	0.9	--	
		IVRCFG=1, VOUTSEL=011	--	1.1	--	
		IVRCFG=1, VOUTSEL=100	--	1.2	--	
		IVRCFG=1, VOUTSEL=101	--	1.4	--	
		IVRCFG=1, VOUTSEL=110	--	1.5	--	
		IVRCFG=1, VOUTSEL=111	--	1.7	--	

## 6 历史版本

版本	日期	修改人	修改说明
Rev1.0	2016.10.06	M.D.	对外发布正式版本第一版
Rev1.1	2017.02.10	M.D	1. 调整文档格式; 2. 添加 I/O 驱动能力描述; 3. 添加电气特性;
Rev1.2	2017.02.11	M.D	去掉了公司 Logo
Rev1.3	2017.05.02	M.D	芯片重新命名
Rev1.4	2017.06.02	M.D	添加外形尺寸
Rev1.4.1	2021.04.29	WU.JH	1.补充工作温度 2.更新 RCH 精度范围: $\pm 1\%$ -> $\pm 1.5\%$ $T_A = -10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ -> $T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$ 。
Rev1.4.2	2021.05.17	FU.MY	1.修改公司名称, 添加 logo 2.修改 HBM 的值
Rev1.4.3	2022.03.31	FU.MY	修改笔误